

2026年3月2日

各 位

J X 金属株式会社

株式会社 Gaianixx の株式追加取得について

J X 金属株式会社（社長：林陽一、以下「当社」）は、東京大学発のスタートアップである株式会社 Gaianixx（代表取締役社長：中尾 健人、以下「Gaianixx 社」）が実施したシリーズ C 1st ラウンド（以下「本ラウンド」）で発行する株式を 7 億円で追加取得しましたので、お知らせいたします。

Gaianixx 社は、独自技術「多能性[®]中間膜」^{※1}を活用し、チタン酸ジルコン酸鉛、炭化ケイ素、窒化ガリウムなど、多様な材料による高品質単結晶薄膜の開発・製造を行っています。「多能性[®]中間膜」は、MEMS、パワー半導体、レーザー、6G フィルタ、光電融合デバイスなど、今後大きな成長が見込まれる市場で、高性能化、軽薄短小化、欠陥低減、コスト削減といった様々な課題に対するブレイクスルーが期待されており、半導体産業分野のゲームチェンジャーとなるポテンシャルを有しています。

同社は、これまでに累計 18.5 億円を資金調達し、現在、同社製品のラボレベルから量産レベルへのスケールアップを視野に事業を展開しています。本ラウンドで調達した資金は、急増する顧客ニーズに応え、デファクトスタンダードを確立するため、量産体制の確立と世界展開を目的に、新拠点の本格稼働、グローバル事業開発と人材採用、知財戦略強化へ重点投資する予定です。

当社は、2023 年 6 月の初回出資^{※2}以降、同社と「多能性[®]中間膜」上への単結晶薄膜形成に向け、スパッタリングターゲットおよびプロセスの開発を共同で進めてきました。これまでの協業を通じて、複数種類の材料で単結晶薄膜の製造に成功し、関連特許の権利化も進展しています。さらに、顧客評価や展示会への共同出展などを通じ、製品化に向けた取り組みを積極的に推進しています。これらの成果により、幅広い分野において「多能性[®]中間膜」の社会実装が着実に進んでいます。

今回の追加出資を機に、両社の連携を一層強化し、他材料への展開や特許出願を通じて競争力をさらに高めるとともに、「多能性[®]中間膜」の技術開発と社会実装を加速させ、Gaianixx 社の事業成長を支援してまいります。

今後も当社は、パートナーとの共創による製品・技術開発に積極的に取り組み、革新的な先端材料の提案・提供を通じて、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

以 上

参考

※1 多能性[®]中間膜：単結晶基板と機能性薄膜の材料の組み合わせを問わず、任意の変形を繰り返すことでひずみを解消できる。より良質な機能性薄膜の積層が可能

※2 2023 年 6 月 20 日プレスリリース「[株式会社 Gaianixx と革新的な半導体形成技術の社会実装に向けた協業を開始](#)」

Gaianixx 社について(2026年3月2日時点)

会社名	株式会社 Gaianixx
本社所在地	東京都文京区本郷7-3-1 東京大学 南研究棟アントレプレナーラボ
代表者	代表取締役社長 CEO 中尾 健人
設立日	2021年10月29日
事業内容	多能性®中間膜及びエピタキシャル研究開発・製造・販売
企業 HP	https://gaianixx.com/